



## Comunicado de prensa

### **KIOXIA y Sandisk presentan una tecnología de memoria flash 3D de nueva generación que alcanza una velocidad de interfaz NAND de 4,8 Gb/s**

*Las empresas presentan la tecnología de memoria flash 3D de 10ª generación que establece un nuevo punto de referencia para el rendimiento, la eficiencia energética y la densidad de bits*

**Alemania, Düsseldorf, 20 de febrero de 2025** – [KIOXIA Corporation](#) y Sandisk Corporation han creado por primera vez una tecnología de memoria flash 3D de última generación, estableciendo el punto de referencia del sector con una velocidad de interfaz NAND de 4,8 Gb/s, una eficiencia energética superior y una mayor densidad.

Presentada en el ISSCC de 2025, la nueva innovación en memoria flash 3D, junto con la revolucionaria tecnología CBA (CMOS directly Bonded to Array)<sup>1</sup> de la empresa, incorpora uno de los últimos estándares de interfaz, Toggle DDR6.0 para memoria flash NAND, y utiliza el protocolo SCA (Separate Command Address)<sup>2</sup>, un novedoso método de entrada de dirección de comando de su interfaz, y la tecnología PI-LTT (Power Isolated Low-Tapped Termination)<sup>3</sup>, que es fundamental para reducir aún más el consumo de energía.

Al sacar partido de esta tecnología única de alta velocidad, las empresas esperan que la nueva memoria flash 3D alcance una mejora del 33 por ciento en cuanto a la velocidad de la interfaz NAND en comparación con su memoria flash 3D de octava generación actualmente en producción en masa, alcanzando así una velocidad de interfaz de 4,8 Gb/s. La tecnología también puede ofrecer una mayor eficiencia energética de la entrada/salida de datos, reduciendo el consumo de energía en un 10 por ciento para la entrada y un 34 por ciento para la salida, logrando así un equilibrio ideal entre un alto rendimiento y un bajo consumo de energía.



Anticipando la memoria flash 3D de 10ª generación, las empresas detallaron que al aumentar el número de capas de memoria a 332 y optimizar el plano de planta para aumentar la densidad plana, la tecnología mejora la densidad de bits en un 59 %.

«Además de la demanda de una mayor eficiencia energética en los centros de datos, la generación de datos también aumentará enormemente, impulsada por las nuevas aplicaciones que utilizan la tecnología de IA, con operaciones sofisticadas como la inferencia en el borde y la aplicación de técnicas de aprendizaje por transferencia que agravan aún más los requisitos de almacenamiento», reflexiona Axel Stoermann, vicepresidente y director de tecnología de KIOXIA Europe GmbH. «KIOXIA continúa sentando las bases para satisfacer estos requisitos de almacenamiento del futuro: velocidades más altas, mayor capacidad y menor consumo de energía».

El vicepresidente sénior de Estrategia Global y Tecnología de Sandisk, Alper Ilkbahar, dijo: «A medida que la IA avanza, los requisitos de memoria de los clientes son cada vez más diversos. Mediante nuestra innovación tecnológica CBA, nuestro objetivo es lanzar productos que ofrezcan la mejor combinación en términos de capacidad, velocidad, rendimiento y eficiencia de capital para atender a nuestros clientes en todos los segmentos del mercado».

KIOXIA y Sandisk también compartieron planes para la próxima memoria flash 3D de 9ª generación. Gracias a su exclusiva tecnología CBA, las empresas son capaces de combinar la nueva tecnología CMOS con una tecnología de celda de memoria existente para ofrecer productos de bajo consumo, alto rendimiento y eficiencia de capital. Ambas empresas mantienen su compromiso con el desarrollo de tecnologías de memoria flash de vanguardia, ofreciendo soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades de los clientes y contribuyendo al avance de la sociedad digital.

# # #

**Notas:**

- 1: Tecnología en la que cada oblea CMOS y oblea de matriz celular se fabrican por separado en su estado optimizado y luego se unen.
- 2: Tecnología en la que el bus para la entrada de comandos/direcciones y el bus para la transferencia de datos están completamente separados en diferentes buses y se utilizan en paralelo. Esto reduce el tiempo de entrada/salida de datos.
- 3: Tecnología en la que se utilizan fuentes de alimentación existentes de 1,2 V y voltaje adicional más bajo para la fuente de alimentación de la interfaz NAND. Esto reduce el consumo de energía durante la entrada/salida de datos.

\*1 Gbps se calcula como 1 000 000 000 bits/segundo. Este valor se obtiene en un entorno de prueba específico y puede variar en función de las condiciones de uso.

\* Los nombres de empresas, nombres de productos y nombres de servicios mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus empresas terceras.

**Declaraciones prospectivas**

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores, incluidas declaraciones relativas a las expectativas de disponibilidad, capacidades e impacto de la tecnología y productos de Sandisk. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la administración y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres más importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas incluyen: desafíos y dificultades operativas, financieras y legales inherentes a la implementación de la escisión del negocio Flash de Western Digital Corporation a Sandisk; los resultados operativos futuros del negocio de flash independiente; si la escisión se completara en los términos previstos y en el plazo previsto o en absoluto, incluida la posibilidad de que no se cumplan las condiciones para la escisión, incluida la posibilidad de que una entidad gubernamental prohíba, retrase o se niegue a conceder una aprobación necesaria; los beneficios y costes esperados de la escisión, incluido el hecho de que los beneficios esperados no se materializaran en el plazo previsto, en su totalidad o en absoluto; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con los clientes, proveedores u otros socios como resultado del anuncio y la finalización de la escisión; respuestas competitivas al anuncio o finalización de la escisión; costes, responsabilidades, cargos o gastos inesperados que resulten de la escisión; litigios relacionados con la escisión; la incapacidad de retener al personal clave como resultado de la escisión, la interrupción del



tiempo de gestión de las operaciones comerciales en curso debido a la escisión; el impacto empresarial de los conflictos geopolíticos; y cualquier cambio en las condiciones económicas generales y/o específicas del sector; otros factores económicos, competitivos, legales, gubernamentales, tecnológicos y de otro tipo que puedan afectar la escisión y otros riesgos e incertidumbres establecidos en la declaración de información final adjunta como Anexo 99.1 a la Declaración de Registro del Formulario 10 de Sandisk Corporation presentada ante la SEC el 27 de enero de 2025, que está disponible en el sitio web de la SEC en [www.sec.gov](http://www.sec.gov). No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha actual, y Sandisk no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas para reflejar nueva información o eventos, excepto según lo exija la ley.

### **Acerca de KIOXIA**

KIOXIA es líder mundial en soluciones de memoria y se dedica al desarrollo, producción y venta de memorias Flash y unidades de estado sólido (SSD). Su empresa predecesora, Toshiba Memory, se separó en abril de 2017 de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria Flash NAND en 1987. El compromiso de KIOXIA es mejorar el mundo con memoria ofreciendo productos, servicios y sistemas que representen opciones para los clientes y un valor añadido para la sociedad basado en la memoria. La innovadora tecnología de memoria Flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASH™, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, como los teléfonos inteligentes avanzados, ordenadores, sistemas automotrices, centros de datos y sistemas de IA generativa. Visite el [sitio web de KIOXIA](#)

### **Acerca de Sandisk**

Sandisk ofrece soluciones Flash innovadoras y tecnologías de memoria avanzadas que satisfacen tanto a personas como a empresas en la intersección entre sus aspiraciones y el presente, lo cual les permite seguir avanzando e impulsando las posibilidades. Sandisk Corporation es una subsidiaria de propiedad total de Western Digital (Nasdaq: WDC). Siga a Sandisk en [Instagram](#), [Facebook](#), [X](#), [LinkedIn](#), [Youtube](#). Siga a [TeamSandisk](#) en Instagram.

### **Información de contacto de Sandisk**

Inversores: [Investors@sandisk.com](mailto:Investors@sandisk.com)

Medios: [Mediainquiries@sandisk.com](mailto:Mediainquiries@sandisk.com)



**Datos de contacto para la publicación:**

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania

Tel.: +49 (0)211 368 77-0

Correo electrónico: [KIE-support@kioxia.com](mailto:KIE-support@kioxia.com)

**Datos de contacto para consultas editoriales:**

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel.: +49 (0) 211 36877 382

Correo electrónico: [lena1.hoffmann@kioxia.com](mailto:lana1.hoffmann@kioxia.com)

**Publicado por:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +49 (0)172 617 8431

Correo electrónico: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

Sitio web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)